

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分
 【発行日】平成28年6月9日 (2016.6.9)

【公表番号】特表2013-531551(P2013-531551A)
 【公表日】平成25年8月8日 (2013.8.8)
 【年通号数】公開・登録公報2013-042
 【出願番号】特願2013-508165(P2013-508165)
 【国際特許分類】

B 0 1 J 23/89 (2006.01)

B 0 1 J 37/34 (2006.01)

B 0 1 J 37/08 (2006.01)

B 8 2 Y 40/00 (2011.01)

B 8 2 Y 30/00 (2011.01)

H 0 1 M 4/88 (2006.01)

H 0 1 M 8/10 (2016.01)

【 F I 】

B 0 1 J 23/89 Z N M M

B 0 1 J 37/34

B 0 1 J 37/08

B 8 2 Y 40/00

B 8 2 Y 30/00

H 0 1 M 4/88 K

H 0 1 M 8/10

【誤訳訂正書】
 【提出日】平成28年4月8日 (2016.4.8)
 【誤訳訂正 1】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 0 2
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【 0 0 0 2 】

米国特許第 5 , 8 7 9 , 8 2 7 号 (この開示内容は参照することにより本明細書に組み込まれる) は、ナノスコピックの針状触媒粒子を有するマイクロ構造針状担体ウイスカを含むナノ構造要素を開示している。この触媒粒子は、組成、合金度又は結晶度が異なり得る、異なる触媒材料が交互に並んだ層を含んでいてもよい。

【誤訳訂正 2】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 0 6
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【 0 0 0 6 】

米国特許第 7 , 4 1 9 , 7 4 1 号 (この開示内容は、参照することにより本明細書に組み込まれる) は、白金層と第 2 の層とをマイクロ構造担体上に交互に堆積することにより形成されるナノ構造を含む燃料電池カソード触媒を開示しており、これは、三元触媒を形成し得る。

【誤訳訂正 3】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 0 7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0007】

米国特許第7,622,217号(この開示内容は、参照することにより本明細書に組み込まれる)は、白金及びマンガン並びに少なくとも1つの他の金属を特定の体積比及びMn含有量で含むナノスコピックの触媒粒子を有するマイクロ構造担体ウィスカを含む燃料電池カソード触媒を開示しており、他の金属は典型的にはNi又はCoである。

【誤訳訂正4】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0010

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0010】

「ナノ構造要素(nanostructured element)」は、表面の少なくとも一部に触媒材料を含む、針状で個別のマイクロスコピック構造(microscopic structure)を意味する。

【誤訳訂正5】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0012

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0012】

「ナノスコピック(nanoscopic)の触媒粒子の薄膜」としては、個別のナノスコピック(nanoscopic)の触媒粒子の膜、結合したナノスコピック(nanoscopic)の触媒粒子の膜、及び結晶質又は非晶質のナノスコピック(nanoscopic)の触媒グレインの膜が挙げられ、典型的には個別の又は結合したナノスコピック(nanoscopic)の触媒粒子の膜が挙げられ、最も典型的には個別のナノスコピック(nanoscopic)の触媒粒子の膜が挙げられる。

【誤訳訂正6】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0014

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0014】

「個別」は、異なる性質を有する別個の要素を意味するが、要素が互いに接触していることを除外しない。

【誤訳訂正7】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

燃料電池用高活性触媒の製造方法であって、

a)(i)基材フィルム上に支持された、針状で個別のマイクロ構造担体ウィスカであって、針状とは、平均断面幅に対する長さの比が3以上であることを意味する、マイクロ構造担体ウィスカと(ii)そのウィスカに担持されたナノスコピック触媒粒子とを含む、ナノ構造薄膜触媒を提供する工程と、

b)100ppm以下の残留酸素濃度を有する不活性ガス下で、少なくとも30mJ/mm²の入射エネルギーフルエンスで照射することによって、前記ナノ構造薄膜触媒を照射アニーリングする工程と、を含む、方法。